05;07;12

Влияние лазерного излучения на проводимость полидиацетилена

© А.Б. Павлинов, И.П. Раевский

Южно-Российский государственный технический университет, Шахтинский филиал

Поступило в Редакцию 4 апреля 2000 г.

Показано, что увеличение темновой проводимости полидиацетилена в результате лазерного облучения в кислородосодержащих средах обусловлено образованием тонких поверхностных проводящих слоев. При использовании лазерных импульсов с энергией $\sim 0.04\,\mathrm{J}$, длиной волны 530 nm и длительностью 20 ns рост удельной электропроводности поверхностных слоев достигает четырех порядков. Предполагается, что фотоокисление является определяющим механизмом лазерной деструкции и последующей стабилизации поверхностных слоев полидиацетилена.

Изучение лазерной обработки полимеров актуально и представляет теоретический и практический интерес с точки зрения их модификации [1], технологии [2,3] и обработки поверхности [4]. Такой полимер, как полидиацетилен (ПДА), представляет собой структуру на основе дизамещенных диацетиленов с сопряженными тройными связями:

$$R - C = C - C = C - R'.$$

Известно, что ПДА по величине проводимости относится к диэлектрикам. Темновая проводимость ПДА, полученного из различных исходных мономеров, находится в интервале значений $10^{-16}-10^{-10}\,\Omega^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$. При этом темновой ток определяется качеством кристаллов, состоянием поверхности, окружающей средой, концентрацией и степенью ионизации локальных центров. В [5] обнаружено изменение проводимости ПДА при действии импульсного лазерного излучения в области сильного поглощения за счет деструкции поверхностного слоя, механизм которой зависит от условий эксперимента.

В данной работе приведены результаты исследования влияния лазерного облучения в различных средах на удельную электропроводность и толщину поверхностных слоев ПДА. Использовались

образцы в виде ромбовидных монокристаллов. Планарные электроды из аквадага наносились вблизи вершин ромба. Это давало возможность прикладывать электрическое поле параллельно, либо перпендикулярно оси полимерной цепи, совпадающей с большой диагональю ромба.

Лазерное облучение образцов производилось по методике [6] со стороны поверхности контактов в атмосфере кислорода, воздуха, азота или в вакууме с остаточным давлением $\sim 0.1\,\mathrm{Pa}$. Для измерений образец и значительно меньший по величине последовательный с ним резистор подключали к источнику постоянного напряжения 300 V. При этом контролировались сопротивление образца до и после облучения, послелазерный отклик тока в указанной цепи, а также толщина, оптическая плотность и окраска проводящего слоя, возникающего на облученной поверхности образца. Использовались лазерные импульсы с энергией $\sim 0.04\,\mathrm{J}$, с длиной волны 530 nm и длительностью 20 ns. После лазерного импульса импульс тока в цепи регистрировался с помощью запоминающего осциллографа, а устанавливающаяся величина стационарного сопротивления — тераомметром с постоянным входным напряжением.

До лазерного облучения производилось сравнение величин темновой проводимости, измеренной в вакууме и в атмосфере азота или воздуха. Измерениям предшествовала длительная выдержка образцов в каждой из указанных сред в отдельности вплоть до стабилизации проводимости во времени. Обнаружено уменьшение величины темновой проводимости на несколько порядков при переходе от измерений на воздухе к измерениям в вакууме. Аналогичный результат получен для образцов, выдержанных в атмосфере азота после воздуха. При этом в ходе выдержки образцов в вакууме или азоте темновой ток уменьшается со временем, приближаясь к постоянным значениям. Обнаружено, что темновой ток, как в вакууме, так и в атмосфере азота, подчиняется закону Ома с экспоненциальной зависимостью электропроводности от температуры. Исследование температурной зависимости электропроводности показало, что основной вклад в концентрацию свободных носителей тока дают локальные центры с энергией активации $\Delta E = 0.8 - 1.0 \, \mathrm{eV}$ независимо от ориентации оси полимерной цепи образца относительно электрического поля.

Было обнаружено, что установление стационарного значения сопротивления образца происходит за ~ 1 ms после лазерного импульса. Про-

4* Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24

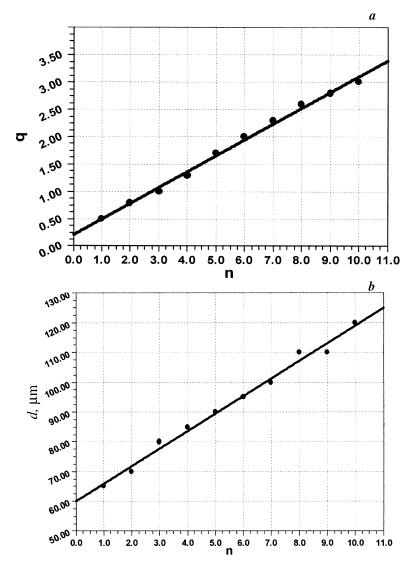


Рис. 1. Зависимость: a — логарифма электропроводности слоя в относительных единицах q от числа лазерных импульсов $n,\ b$ — толщины слоя d от числа лазерных импульсов n.

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24

изводились оценки стационарной электропроводности образца (рис. 1, a) и толщины образующегося поверхностного слоя (рис. 1, b). На рис. 1, a представлена зависимость величины q-логарифма электропроводности образца Σ после облучения в атмосфере кислорода к соответствующей величине Σ_0 до облучения от числа лазерных импульсов n. Аналогично получается близкий результат при лазерном облучении на воздухе. Как следует из рис. 1, a, величина Σ увеличивается с ростом n по закону, близкому к экспоненциальному, и при $n \geqslant 3$ величина $\Sigma/\Sigma_0 \geqslant 10$ и можно считать, что электропроводность образца практически определяется поверхностным слоем, модифицированным в результате лазерного облучения. Эксперименты с механическим или химическим удалением поверхностных слоев и оптическими измерениями обнаружили близкую к линейной зависимость толщины проводящего слоя d от числа импульсов n (рис. 1, b). Причем удаление поверхностного слоя практически полностью восстанавливает исходное состояние облученного образца.

Произведем оценку влияния лазерного облучения на коэффициент электропроводности σ исследуемого материала. Принимая, что поперечное сечение проводящего слоя для прохождения тока $\approx d$, можно записать следующее выражение для величины σ :

$$\sigma/\sigma_0 = \Sigma/\Sigma_0 d_0/d$$
,

где σ_0 , d_0 — коэффициент электропроводности и толщина исходного образца соответственно. На рис. 2 приведена зависимость от n величины k-логарифма отношения удельной проводимости проводящего слоя σ после облучения к соответствующей величине σ_0 до облучения при $n \geqslant 3$, т.е. для случая, когда шунтирующим действием образца можно пренебречь.

Следует отметить, что проводящие слои, полученные и содержащиеся в атмосфере кислорода, сохраняют стабильность электропроводности со временем. Однако проводимость слоев, полученных при лазерном облучении на открытом воздухе, со временем уменьшается, приближаясь к исходной величине до облучения, т.е. сопротивление образцов восстанавливается. Скорость восстановления увеличивается при освещении лампой накаливания.

После облучения образцов в вакууме или в азоте их сопротивление падает, а затем восстанавливается за время $\approx 1\,\mathrm{ms}$, что может быть

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 24

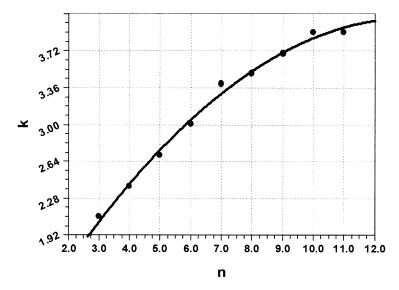


Рис. 2. Зависимость логарифма коэффициента электропроводности слоя в относительных единицах k от числа лазерных импульсов n.

объяснено нестационарными тепловыми процессами. Следовательно, в этих случаях необратимых изменений проводимости после лазерного облучения не происходит.

Таким образом, влияние лазерного облучения на проводимость ПДА обусловлено образованием проводящих поверхностных слоев в кислородосодержащих средах. Стабильность проводящих слоев, полученных и сохраняющихся в атмосфере кислорода, позволяет предположить, что их образование связано с фотоокислением поверхностного слоя ПДА под действием лазерного излучения. Окраска облучению поверхности отличается от исходной и после многократного облучения приближается к красному цвету. Обнаружено существенное увеличение (на ~ 1.0) оптической плотности образцов в области длин волн $500-700\,\mathrm{nm}$ за счет поглощения в облученном поверхностном слое как следствие модификации структуры поверхностных слоев.

Список литературы

- [1] Pool N.J. et al. // J. Mater. Sci. 1986. V. 21. N 2. P. 507.
- [2] Masuhara H. et al. // Chem. Phys. Lett. 1987. V. 135. N 1, 2. P. 103.
- [3] Srinivasan R. // Polym. Degradation and Stability. 1987. V. 17. N 3. P. 193.
- [4] Huang Y., Lou Q., Xu J., Dong J., Wei Y. // Chin. J. Laers. A. 1999. V. 26. N 8. P. 745–748.
- [5] Павлинов А.Б., Трайдук Т.Л., Журавлева Т.С., Ванников А.В. // ХВЭ. 1989. Т. 23. С. 181–182.
- [6] *Павлинов А.Б.* // Изв. вузов Сев.-Кавк. регион. Естественные науки. 2000. № 2. С. 90–94.